# Самоорганизиращи се нанопорести оксиди на вентилни метали

Структура, получаване, приложение като инертни матрици за получаване на наноточки, нанотелчета и нанотръбички

лектор: доц. Боряна Цанева

#### Вентилни метали

- Покриват се с тънък оксиден слой с диелектрични свойства
  - предимства предпазва от корозия
  - недостатък затруднява запояването
- Проявяват различни свойства в зависимост от поляритета на приложеното напрежение



#### Проводник и електрод

#### електронни проводници:



#### йонни проводници (електролити):





#### Електрохимия

#### Електродни реакции в електрохимичните вериги:

анодна полуреакция:  $\operatorname{Red}_1 - \operatorname{ne}^- \to \operatorname{Ox}_1$ катодна полуреакция:  $\operatorname{Ox}_2 + \operatorname{ne}^- \to \operatorname{Red}_2$ обща електрохимична реакция:  $\operatorname{Red}_1 + \operatorname{Ox}_2 \to \operatorname{Ox}_1 + \operatorname{Red}_2$ 



напрежение – движеща сила на реакцията електричен ток – скорост на реакцията



#### Електролиза: анодни процеси





Har Se



#### Получаване

- анодно окисление на алуминия:  $2AI + 3H_2O - 6e \rightarrow Al_2O_3 + 6H^+$  $(2H_2O - 4e \rightarrow O_2 + 4H^+)$
- химично разтваряне на получения алуминиев оксид

 $\mathrm{AI}_2\mathrm{O}_3 + \mathrm{6H}^+ \longrightarrow \mathrm{AI}^{3+} + \mathrm{3H}_2\mathrm{O}$ 

тънък, плътен вътрешен слой (бариерен)
 0,01-0,1 μm от γAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> с вентилно действие
 дебел (до 500 μm), силно порест слой.



#### Структура



[Lee, W.; Ji, R.; Gösele, U.; Nielsch, K. Nat. Mater. 2006, 5, 741.]



Typical HRSEM image of the templates used in this work. The pore diameter mean value range from 35 to 40 nm and inter-pore spacing range from 100 to 105 nm [Appl. Phys. A 80, 1701–1706 (2005)]

## Структура



#### Зависят от:

- електрични параметри на електролизата;
- температура и състав на електролита;
- продължителност;
- разширяване на порите след анодиране.



#### Механизъм на самоструктуриране



#### Механизъм на самоструктуриране



#### Възпроизводим контрол на структурата





[Lee, W.; Kim, J.-C.; Gösele, U. Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 21]

#### Промяна на структурата след анодиране

<u>Разширяване на порите</u> – възможно е поради анизотропното (не еднакво в трите измерения) разтваряне на анодния оксид. Той се разтваря със значително по-голяма скорост в посока изтъняване на стените на клетките, от колкото на дебелината на слоя.



влияние на концентрацията и температурата



след разширяване: 5% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, 35°C, 30 min крайна дебелина ~7 µm

250

#### Промяна на структурата след анодиране

Разширяване на порите с кисел разтвор :

 Престоят в кисел разтвор (напр. фосфорна или оксалова киселина) на мембрана от аноден алуминиев оксид <u>с бариерен слой</u> води до конично сечение на порите със стесняване към бариерния слой.



#### Промяна на структурата след анодиране

Престоят в кисел разтвор на мембрана от аноден алуминиев оксид без бариерен слой води до цилиндрично сечение на порите



Схематично представяне на разширяване на порите след предварително отстраняване на бариерния слой.



#### Предимства на нанопорестия ААО

- висока плътност на порите;
- прецизно и възпроизводимо регулиране на размера на порите;
- термична и електрична стабилност;
- висока твърдост и якост на натиск;
- широка област на оптична прозрачност;
- евтин и непретенциозен метод за получаване.

различни типове сензори (налягане, температура, концентрация, скорост и т.н.);

и микронагреватели;

• мембрани за ултра- и нанофилтрация;

• матрица за израстване на подредени нанотелчета;

□ шаблон за нанолитография;

шаблон от Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-мембрана за нанолитография за получаване на супер решетъчни структури от Si, GaAs и GaN субстрати чрез йонно ецване.





SEM изображение на подредени наноточки от Si



Изображение от атомно-силов микроскоп на нанопорест GaAs след ецване през маска от AAO: (а) изглед от горе и (б) 3D изображение

Условия за сухо ецване:

Substrate	Si	GaAs	GaN
Gas	$CBrF_3 + CF_4$	BCl <sub>3</sub>	Cl <sub>2</sub>
Flow rate (sccm)	10+2	20	60
Pressure (mTorr)	70	15	80
Power (W)	80	100	200

#### Приложение:

- > проводящи изображения върху диелектрична повърхност
- различни сензори (за газ, температура, налягане и др.)
- > микронагреватели . . .



Пример: електрохимично запълване на нанопори с метал



 $M^{n+} + ne^- \rightarrow M^{\circ}$ 









WD: 8.527 mm Det: SE 5 μm Date(m/d/y): 07/10/13 Performance in nanospace



Det: SE Vac: HiVac 5 µm Performance in nanospace SEM MAG: 10.00 kx Date(m/d/y): 11/20/13



Performance in nanospace



Типични SEM изображения на слоеве от аноден алуминиев AAO (a) и титанов ATO (b) оксид. AAO филмът се приготвя чрез двуетапно анодиране: алуминиева пластина се анодира в 0,3 М оксалова киселина при 40 V в продължение на 3 часа, слоят от порест оксид се отстранява чрез смесен разтвор на хромова и фосфорна киселина и пластината се анодира отново за 10 ч. ATO филмът се формира при анодиращо напрежение 60 V за 16 часа

## ТіО<sub>2</sub> - получаване



- хидротермален
- ЗОЛ-ГЕЛ
- послойно атомно отлагане
- електрохимично предимства:
  - ▶ бързо израстване,
  - ▶ възпроизводим контрол на размерите,
  - подредени нанотръбички,
  - евтин и непретенциозен метод

свободни или под форма на клъстери нанотръбички с различен размер

## Електрохимичен синтез на TiO<sub>2</sub>

- Кисели електролити (HF) до няколко стотин нанометра (15-25 V)
- Буферирани неутрални електролити (NaF, KF, NH<sub>4</sub>F) до няколко µm
- Безводни органични полярни електролити (етиленгликол) до 1 mm (80-120 V)





### Етапи на израстване на аноден ТіО<sub>2</sub>



начален етап – плътен слой (1-2 min)



- втори етап начало на порест слой (10-15 min)
- трети етап установяване на квазистатично състояние

## Процеси при формиране на ТіО<sub>2</sub>



▶ електрохимичено разтваряне:
(A) Ti – 4e<sup>-</sup> → Ti<sup>4+</sup>
(K) 4H<sup>+</sup> + 4e<sup>-</sup> → H<sub>2</sub>

≻ химично разтваряне Ti + H<sub>2</sub>O → TiO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub> TiO<sub>2</sub> + 6F<sup>-</sup> + 4H<sup>+</sup> → TiF<sub>6</sub><sup>-2</sup> + 2H<sub>2</sub>O





#### ДОЛУ – граница Ti/TiO<sub>2</sub>

#### странично

ГОРЕ – граница ТіО<sub>2</sub>/електролит

изглед от:

## Формиране на нанопори при различна степен на диелектричния пробив



Схематична диаграма, илюстрираща образуването на нанопорьозни анодни оксиди, когато степента на локализиран диелектричен пробив е ниска (а-с), и образуването на нанотръбни анодни оксиди с ръбове между съседните тръби, когато степента на локализиран диелектричен пробив е висока (d-g). Стрелките показват потенциалните посоки на движение навътре на кислородните аниони.

[J. Mater. Chem., 2012, 22, 535–544]



- (а) ТЕМ изображения, показващи типични дъна на нанотръби от аноден TiO<sub>2</sub>,
- (b) две съседни нанотръби с периодично разположени О-пръстени като хребети около стените,
- (с) единична нанотръба с груба външна повърхност.
- (d) SEM изображение на голяма площ от напречно сечение на нанотръбички от аноден титанов диоксид с ръбове като О-пръстени

[J. Mater. Chem., 2012, 22, 535–544]

## Приложение на ТіО<sub>2</sub>

- Фотоволтаици
- Фотокатализ
- Фотоелектролиза
- Газови сензори
- Биомедицински импланти
- батерии

## Други метали

- Хафний висока химична и термична стабилност, висок отражателен индекс и относително висока диелектрична константа (50 V, 1 M H2SO4 + 0.2 wt% NaF)
- Ниобий Ni<sub>2</sub>O<sub>5</sub> приложение за газови сензори, катализа, оптични и електрохромни устлойства. Дебелина до 0,5 um от 1 М H2SO4 + 1 wt% HF and 1.5% HF
- Тантал Та<sub>2</sub>O<sub>5</sub> оптични устройства и защитни покрития за химични процеси,
  - ▶ от електролити на сярна и фосфорна киселина, натриев сулфат аморфен
  - ➤ ot 1 M H2SO4 + 2 wt % HF 20 V самоподреден порест оксиден слой
- Волфрам WO<sub>3</sub> Газови сензори, електрохромни и фотохромни процеси оксалова при 35V
- Ванадий V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> от натриев тартарат

#### Аноден Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> за преобразуване на слънчева енергия



- (a) FESEM изображение на напречно сечение на  $Nb_2O_5$  NTs, анодирани в 1M  $H_2SO_4$  + 1 wt% HF (10 минути, 20 V).
- (b) FESEM изображение на напречно сечение на  $Nb_2O_5$ , анодиран в 1 wt% HF+1 M  $H_3PO_4$  (1 h, 2.5 V).
- (c & d) Изглед отгоре и FESEM изображения на напречно сечение на порьозен Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, приготвен чрез анодиране-отгряване, анодизация в 1 тегл.% HF + 1 M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (150 °C, 2,5 V, 2 h).

### Аноден $Ta_2O_5$



SEM изглед отгоре на нанопорести  $Ta_2O_5$  филми, израстнати анодно в 0,2 M NH4F, съдържащ етиленгликол 5 vol %/глицерол електролит при 20 V с различни количества (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: (a) 0, (b) 0,05, (c) 0,05 и (d) 0,15. (b) Преходни токове записани по време на анодирането на Та в a-d.

#### Фактори влияещи върху пробивното напрежение

- Природа на анодирания метал
   Zr (300 V) > Al (245 V) > Ta (200 V) > Nb (190 V)
- Електролит природа, концентрация
    $U_{\rm B}$  = A + B log  $\rho_{\rm e}$
- Плътност на тока слабо влияние (500 пъти увеличение намаля до до 15%); води до увеличаване на дефектите; U<sub>MB</sub> = A<sub>MB</sub> + B<sub>MB</sub> log j A<sub>MB</sub> и B<sub>MB</sub> зависят от йонния състав на електролита
- Други фактори състояние на повърхността (дефекти), температура...



#### Литературни източници:

- Dusan Losic, Abel Santos, Electrochemically Engineered Nanoporous Materials: Methods, Properties and Applications, Springer, Springer International Publishing Switzerland 2015, ISSN 2196-2812 (electronic), DOI 10.1007/978-3-319-20346-1
- Woo Lee, Sang-Joon Park, Porous Anodic Aluminum Oxide: Anodization and Templated Synthesis of Functional Nanostructures, Chem. Rev. 2014, 114, 7487–7556, dx.doi.org/10.1021/cr500002z
- Zixue Su, Wuzong Zhou, Feilong Jiang and Maochun Hong, Anodic formation of nanoporous and nanotubular metal oxides, J. Mater. Chem., 2012, 22, 535-544, DOI: 10.1039/c1jm13338a
- A.M.M. Jani, D. Losic, N,H. Voelcker, Nanoporous anodic aluminium oxide: Advances in surface engineering and emerging applications, Progress in Materials Science 58 (2013) 636–704